(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 23. Oktober 2003 (23.10.2003)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 03/087426 A2

(51) Internationale Patentklassifikation7: C23C 14/34

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE03/01216

(22) Internationales Anmeldedatum:

11. April 2003 (11.04.2003)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

102 16 671.4

15. April 2002 (15.04.2002) US

- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): APPLIED FILMS GMBH & CO. KG [DE/DE]; Siemensstrasse 100, 63755 Alzenau (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): GEISLER, Michael [DE/DE]; Triebstrasse 63, 63607 Wächtersbach (DE). KASTNER, Albert [DE/DE]; Hanauer Landstrasse 37 b, 63457 Hanau (DE). SZYSZKA, Bernd [DE/DE]; Danzinger Strasse 24, 38108 Braunschweig (DE). PFLUG, Andreas [DE/DE]; Berliner Allee 43, 30175 Hannover (DE). MALKOMES, Niels [DE/DE]; Karlstrasse 75, 38106 Braunschweig (DE).
- (74) Anwalt: SCHLAGWEIN, Udo; Frankfurter Strasse 34, 61231 Bad Nauheim (DE).

- (81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT (Gebrauchsmuster), AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ (Gebrauchsmuster), CZ, DE (Gebrauchsmuster), DK (Gebrauchsmuster), DK, DM, DZ, EC, EE (Gebrauchsmuster), EE, ES, FI (Gebrauchsmuster), FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK (Gebrauchsmuster), SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

 ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: COATING INSTALLATION

(54) Bezeichnung: BESCHICHTUNGSANLAGE

(57) Abstract: The invention relates to a coating installation comprising a recipient (1) which is divided into a cathode side (3) and a substrate side (4) by means of a screen (2). The cathode side (3) and the substrate side (4) respectively have a direct extraction outlet (10, 16) and a gas admission (8, 14). The gas admission (8) on the cathode side (3) is connected to a process gas source (9) and the gas admission (14) for the substrate side (4) is connected to a reactive gas source (15).

(57) Zusammenfassung: Bei einer Beschichtungsanlage ist ein Rezipient (1) durch eine Blende (2) in einen Kathodenraum (3) und einen Substratraum (4) unterteilt. Sowohl der Kathodenraum (3) als auch der Substratraum (4) weisen eine unmittelbare Absaugung (10, 16) und jeweils eine eigene Gaszuführung (8, 14) auf. Die Gaszuführung (8) in den Kathodenraum (3) ist mit einer Prozessgasquelle (9) und die Gaszuführung (14) für den Substratraum (4) mit einer Reaktivgasquelle (15) verbunden.



Beschreibung

Beschichtungsanlage

Die Erfindung betrifft eine Beschichtungsanlage mit einem eine Absaugung und eine Gaszuführung aufweisenden Rezipienten, in welchem eine Zerstäuberkathode und ein Substrathalter untergebracht sind und bei der der Rezipient durch eine zwischen der Zerstäuberkathode und dem Substrathalter angeordnete Blende in einen Kathodenraum und einen Substratraum unterteilt ist.

Eine Beschichtungsanlage der vorstehenden Art ist Gegenstand der EP 0 795 623. Bei der in dieser Schrift gezeigten Beschichtungsanlage strömt aus Argon und Sauerstoff Prozessgas nahe des Substrates Substratraum und wird oberhalb der Blende über eine Absaugung am Kathodenraum abgeführt. Eine als Lambda-Sonde ausgeführte Messeinrichtung im Kathodenraum dient dazu, den Sauerstoffgehalt im Kathodenraum zu überwachen und nach dem Sauerstoffgehalt die Leistung der Zerstäuberkathode zu steuern. Durch die gemeinsame Zuführung des Reaktivgases und des Prozessgases und durch die Abführung des Gases über eine Absaugung am Kathodenraum lässt sich nicht vermeiden, dass das Target der Zerstäuberkathode einer beträchtlichen Sauerstoffkonzentration ausgesetzt ist. Dadurch kommt es zu einer unerwünschten Oxidation des Targets, wodurch sich anstelle einer erwünschten hohen metallischen Oxidationsrate eine niedrige oxidische Oxidationsrate ergibt. Die Blende gemäß der EP 0 795 623 hat den Sinn, eine Minderung der Schichtqualität durch Schrägbeschichtung zu unterbinden.

Der Erfindung liegt das Problem zugrunde, eine Beschichtungsanlage der eingangs genannten Art so zu gestalten, dass eine ausreichend hohe Konzentration von Reaktivgas möglich ist, um eine vollständige Reaktion der sich bildenden Schicht zu ermöglichen, ohne dass dadurch zugleich die Targetoberfläche in unerwünschter Weise mit dem Reaktivgas reagiert und es dadurch zu einer Leistungsverminderung der Beschichtungsanlage kommt.

Dieses Problem wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass sowohl der Kathodenraum als auch der Substratraum eine unmittelbare Absaugung und jeweils eine eigene Gaszuführung aufweisen und dass die Gaszuführung in den Kathodenraum mit einer Prozessgasquelle und die Gaszuführung für den Substratraum mit einer Reaktivgasquelle Verbindung hat.

Durch diese Gestaltung der Beschichtungsanlage kommt es zu weitgehend unabhängigen Gasströmungen in dem Kathodenraum und dem Substratraum. Das Reaktivgas wird erfindungsgemäß durch die Blende vom Sputtervorgang schirmt. Dadurch gelangen nur noch unbedeutende Mengen des Reaktivgases - im Regelfall Sauerstoff - in den Kathodenraum, so dass es zu keiner Reaktion der Targetoberfläche und damit einer Verringerung der Beschichtungsleistung der Beschichtungsanlage kommt. Der Fluss der die Schicht bildenden, von der Targetoberfläche stammenden Teilchen gelangt durch die Öffnung der Blende hindurch zum Substrat. Dank der erfindungsgemäßen Ausbildung von zwei separaten Gasströmungen im Rezipienten kann die Öffnung in der Blende groß sein, so dass die von der Targetoberfläche stammenden Teilchen auf dem Weg zum Substrat wenig behindert werden, ohne dass umgekehrt unerwünscht viel Sauerstoff die Zerstäubungskathode erreicht und es dort zu einer Oxidation kommt. Es zeigte sich, dass die Abblendwirkung der Blende für die gesputterten Teilchen

sich durch die mögliche Ratenerhöhung am Target aufgrund des dort geringeren Reaktivgasanteils überkompensieren lässt. Besonders deutliche Steigerungen der spezifischen Beschichtungsleistung ergaben sich mit der erfindungsgemäßen Beschichtungsanlage bei der Erzeugung von transparenten SnO- und ZnO-Schichten mit reaktiv betriebenen DC-Zerstäuberkathoden.

Eine besonders gute Trennung der Gasströme ergibt sich, wenn der Kathodenraum und der Substratraum jeweils mit einem eigenen Unterdruckpumpstand verbunden sind.

Zur weiteren Trennung der beiden Gasströme trägt es bei, wenn sowohl im Kathodenraum als auch im Substratraum die Gaszuführung und die Absaugung an gegenüberliegenden Seiten angeordnet sind.

Zur weiteren Verbesserung der Schichtqualität trägt es bei, wenn im Rezipienten zwischen der Zerstäuberkathode und dem Substrat eine Anode angeordnet ist.

Der Einfluss des Plasmaglows auf das Schichtwachstum wird möglichst wenig gehemmt, wenn gemäß einer anderen Weiterbildung der Erfindung die Anode im Substratraum von der Blende abgedeckt zwischen der Blende und dem Substrathalter angeordnet ist. Eine solche Anode bewirkt, dass sich der Plasmaglow durch die Blendenöffnung hindurch über die Beschichtungsstelle des Substrates hinweg in Richtung der Schlitzschleuse erstreckt. Hierdurch lassen sich auch die Schichteigenschaften verbessern. Insbesondere ist durch eine solche Anodenanordnung eine hohe Schichtdichte zu erreichen. Da die Anode von der Blende abgedeckt ist, kommt es zu keiner nennenswerten Beschichtung der Anode.

Die Anode kann auf übliche Weise ausgebildet sein. Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Anode durch zwei unbe-

heizte Rohre gebildet ist. Da SnO und ZnO eine relativ hohe Leitfähigkeit besitzen, spielt die während des Beschichtungsvorganges des Substrates zwangsläufig erfolgende Beschichtung der Anode und ihr damit eintretender Wirkungsverlust bei solchen Beschichtungsmaterialien keine Rolle. Es kann jedoch auch vorgesehen werden, die Anode, umgeben mit einem schwachen Magnetfeld, pulsweise auf negatives Patential zu setzen, um sie leitfähig und sauber zu halten.

Möglich ist es jedoch auch vorzusehen, dass die Anode zugleich die Blende bildet.

Der weiteren Leistungssteigerung der Beschichtungsanlage dient es, wenn die Kathode eine Doppel-Magnetronkathode ist.

Das Target wird möglichst gleichmäßig abgetragen und hat deshalb eine möglichst lange Lebensdauer, wenn gemäß einer anderen Weiterbildung der Erfindung die Kathode eine Rotationskathode ist.

Oxidische und damit geringe Erosionsraten des Targets lassen sich zuverlässig vermeiden, wenn gemäß einer anderen Weiterbildung der Erfindung im Kathodenraum eine Messeinrichtung für Reaktivgas angeordnet ist und die Beschichtungsanlage eine Leistungsregelung der Zerstäuberkathode in Abhängigkeit von der Konzentration des Reaktivgases in dem Kathodenraum aufweist.

Als besonders vorteilhaft hat sich herausgestellt, wenn das Verhältnis der in Transportrichtung des Substrates gemessenen Blendenöffnungslänge der Blende zur in Transportrichtung des Substrates gemessenen Breite der Zerstäuberkathode weniger als 0,75, vorzugsweise 0,5 bis 0,3 beträgt.

Die Erfindung lässt verschiedene Ausführungsformen zu. Zur weiteren Verdeutlichung ihres Grundprinzips ist eine davon schematisch in der Zeichnung dargestellt und wird nachfolgend beschrieben.

Die Zeichnung zeigt im Schnitt eine erfindungsgemäße Beschichtungsanlage. Diese hat einen Rezipienten 1, der durch eine Blende 2 in einen Kathodenraum 3 und einen Substratraum 4 unterteilt ist. Im Kathodenraum 3 befindet sich eine elektrisch gegenüber dem Rezipienten 1 isolierte Zerstäuberkathode 5, die bei diesem Ausführungsbeispiel als Magnetronkathode ausgebildet ist und an der Seite der Blende 2 ein Target 6 aufweist. Unterhalb der Blende 2 und von dieser abgedeckt ist im Substratraum 4 eine Anode 7 angeordnet. In der Zeichnung gesehen an der linken Seite des Kathodenraumes 3 befindet sich eine Gaszuführung 8, die mit einer Prozessgasquelle 9 verbunden ist. An der gegenüberliegenden Seite des Kathodenraumes 3 ist eine Absaugung 10 mit einem Unterdruckpumpstand 11 angeordnet.

Im Substratraum 4 befindet sich ein Substrathalter 12 mit einem zu beschichtenden Substrat 13. Das Verhältnis der in Transportrichtung des Substrates 13 gemessenen Blendenöffnungslänge der Blende 2 zur in Transportrichtung des Substrates 13 gemessenen Breite der Zerstäuberkathode 5 beträgt weniger als 0,75, vorzugsweise 0,5 bis 0,3. Genau wie der Kathodenraum 3 hat der Substratraum 4 an der gleichen Seite wie der Kathodenraum 3 eine Gaszuführung 14, die mit einer Reaktivgasquelle 15 Verbindung hat. Weiterhin ist der Gaszuführung 14 gegenüberliegend eine Absaugung 16 mit einem Unterdruckpumpstand 17 vorgesehen.

Zur Regelung des Beschichtungsvorganges ist in dem Kathodenraum 3 eine als Lambdasonde ausgebildete Messeinrich-

tung 18 mit einer Sondenheizung 20 angeordnet, welche mit einer Leistungsregelung 19 der Zerstäuberkathode 5 Verbindung hat. Dadurch wird die Konzentration des Reaktivgases in dem Kathodenraum 3 - im Regelfall die Sauerstöffkonzentration - gemessen und danach die Spannung der Zerstäuberkathode 5 geregelt.

Bezugszeichenliste

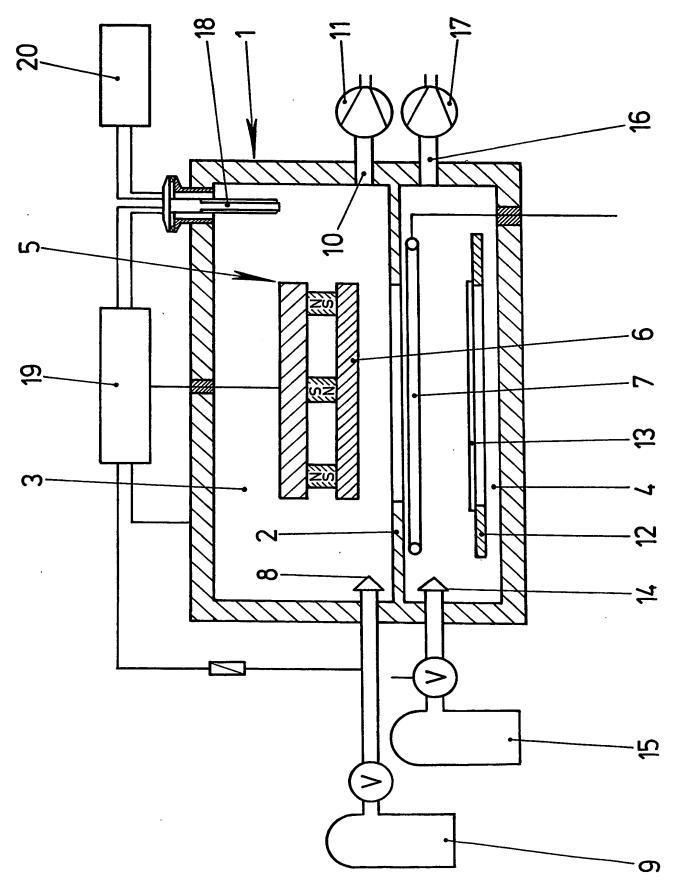
- 1 Rezipient
- 2 Blende
- 3 Kathodenraum
- 4 Substratraum
- 5 Zerstäuberkathode
- 6 Target
- 7 Anode
- 8 Gaszuführung
- 9 Prozessgasquelle
- 10 Absaugung
- 11 Unterdruckpumpstand
- 12 Substrathalter
- 13 Substrat
- 14 Gaszuführung
- 15 Reaktivgasquelle
- 16 Absaugung
- 17 Unterdruckpumpstand
- 18 Messeinrichtung
- 19 Leistungsregelung
- 20 Sondenheizung

Patentansprüche

- 1. Beschichtungsanlage mit einem eine Absaugung und eine Gaszuführung aufweisenden Rezipienten (1), in welchem eine Zerstäuberkathode (5) und ein Substrathalter (12) untergebracht sind und bei der der Rezipient (1) durch eine zwischen der Zerstäuberkathode (5) und dem Substrathalter (12) angeordnete Blende (2) in einen Kathodenraum (3) und einen Substratraum (4) unterteilt ist, dadurch gekennzeichnet, dass sowohl der Kathodenraum (3) als auch der Substratraum (4) eine unmittelbare Absaugung (10, 16) und jeweils eine eigene Gaszuführung (8, 14) aufweisen und dass die Gaszuführung (8) in den Kathodenraum (3) mit einer Prozessgasquelle (9) und die Gaszuführung (14) für den Substratraum (4) mit einer Reaktivgasquelle (15) Verbindung hat.
- 2. Beschichtungsanlage nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Kathodenraum (3) und der Substratraum
 (4) jeweils mit einem eigenen Unterdruckpumpstand (11,
 17) verbunden sind.
- 3. Beschichtungsanlage nach den Ansprüchen 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass sowohl im Kathodenraum (3) als auch im Substratraum (4) die Gaszuführung (8, 14) und die Absaugung (10, 16) an gegenüberliegenden Seiten angeordnet sind.
- 4. Beschichtungsanlage nach zumindest einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass im Rezipienten (1) zwischen der Zerstäuberkathode (5) und dem Substrat (13) eine Anode (7) angeordnet ist.
- 5. Beschichtungsanlage nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Anode (7) im Substratraum (4) von der

- Blende (2) abgedeckt zwischen der Blende (2) und dem Substrathalter (12) angeordnet ist.
- 6. Beschichtungsanlage nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Anode (7) durch zwei unbeheizte Rohre
 gebildet ist.
- 7. Beschichtungsanlage nach zumindest einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Anode (7) zugleich die Blende (2) bildet.
- 8. Beschichtungsanlage nach zumindest einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Zerstäuberkathode (5) eine Doppel-Magnetronkathode ist.
- 9. Beschichtungsanlage nach zumindest einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Zerstäuberkathode (5) eine Rotationskathode ist.
- 10. Beschichtungsanlage nach zumindest einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass im Kathodenraum (3) eine Messeinrichtung (18) für Reaktivgas angeordnet ist und die Beschichtungsanlage eine Leistungsregelung (19) der Zerstäuberkathode (5) in Abhängigkeit von der Konzentration des Reaktivgases in dem Kathodenraum (3) aufweist.
- 11. Beschichtungsanlage nach zumindest einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Verhältnis der in Transportrichtung des Substrates (13) gemessenen Blendenöffnungslänge der Blende (2) zur in Transportrichtung des Substrates (13) gemessenen Breite der Zerstäuberkathode (5) weniger als 0,75, vorzugsweise 0,5 bis 0,3 beträgt.

1



(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 23. Oktober 2003 (23.10.2003)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2003/087426 A3

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: C23C 14/00, H01J 37/34

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2003/001216

(22) Internationales Anmeldedatum:

11. April 2003 (11.04.2003)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 102 16 671.4 15.

15. April 2002 (15.04.2002) US

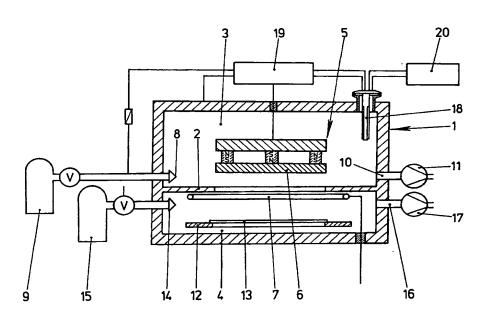
(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): APPLIED FILMS GMBH & CO. KG [DE/DE]; Siemensstrasse 100, 63755 Alzenau (DE).

- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): GEISLER, Michael [DE/DE]; Triebstrasse 63, 63607 Wächtersbach (DE). KASTNER, Albert [DE/DE]; Hanauer Landstrasse 37 b, 63457 Hanau (DE). SZYSZKA, Bernd [DE/DE]; Danzinger Strasse 24, 38108 Braunschweig (DE). PFLUG, Andreas [DE/DE]; Berliner Allee 43, 30175 Hannover (DE). MALKOMES, Niels [DE/DE]; Karlstrasse 75, 38106 Braunschweig (DE).
- (74) Anwalt: SCHLAGWEIN, Udo; Frankfurter Strasse 34, 61231 Bad Nauheim (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT (Gebrauchsmuster), AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ (Gebrauchsmuster), CZ, DE (Gebrauchsmuster), DK (Gebrauchsmuster).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: COATING INSTALLATION

(54) Bezeichnung: BESCHICHTUNGSANLAGE



(57) Abstract: The invention relates to a coating installation comprising a recipient (1) which is divided into a cathode side (3) and a substrate side (4) by means of a screen (2). The cathode side (3) and the substrate side (4) respectively have a direct extraction outlet (10, 16) and a gas admission (8, 14). The gas admission (8) on the cathode side (3) is connected to a process gas source (9) and the gas admission (14) for the substrate side (4) is connected to a reactive gas source (15).

(57) Zusammenfassung: Bei einer Beschichtungsanlage ist ein Rezipient (1) durch eine Blende (2) in einen Kathodenraum (3) und einen Substratraum (4) unterteilt. Sowohl der Kathodenraum (3) als auch der Substratraum (4) weisen eine unmittelbare Absaugung (10, 16) und jeweils eine eigene Gaszuführung (8, 14) auf. Die Gaszuführung (8) in den Kathodenraum (3) ist mit einer Prozessgasquelle (9) und die Gaszuführung (14) für den Substratraum (4) mit einer Reaktivgasquelle (15) verbunden.



DK, DM, DZ, EC, EE (Gebrauchsmuster), EE, ES, FI (Gebrauchsmuster), FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK (Gebrauchsmuster), SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen
- (88) Veröffentlichungsdatum des internationalen Recherchenberichts: 19. Februar 2004

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen. A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 C23C14/00 H01J37/34

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 C23C H01J

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ, INSPEC, COMPENDEX

Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.		
EP 0 908 531 A (CANON KK) 14 April 1999 (1999-04-14)	1,3,4,6, 7,11		
paragraphs '0033!-'0035!,'0041!,'0042!; figure 2 	5,8-10		
EP 0 860 513 A (CANON KK) 26 August 1998 (1998-08-26) column 16, line 52 -column 18, line 14; figure 9	1,2,4,6, 7,11		
US 4 392 939 A (CROMBEEN JACOBUS E ET AL) 12 July 1983 (1983-07-12) column 2, line 60 -column 3, line 19; figure 1	5		
-/			
	EP 0 908 531 A (CANON KK) 14 April 1999 (1999-04-14) paragraphs '0033!-'0035!,'0041!,'0042!; figure 2 EP 0 860 513 A (CANON KK) 26 August 1998 (1998-08-26) column 16, line 52 -column 18, line 14; figure 9 US 4 392 939 A (CROMBEEN JACOBUS E ET AL) 12 July 1983 (1983-07-12) column 2, line 60 -column 3, line 19; figure 1		

X Further documents are listed in the continuation of box C.	χ Patent family members are listed in annex.
 Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed 	 "T" later document published after the International filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. "&" document member of the same patent family
Date of the actual completion of the International search 8 December 2003	Date of mailing of the international search report 17/12/2003
Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Authorized officer Hoyer, W

PCT/UL 03/01216

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
ategory Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
US 5 427 665 A (HARTIG KLAUS ET AL) 27 June 1995 (1995-06-27) column 3, line 53 -column 4, line 51; claims 1,6,8; figures 2-4	8,9
EP 0 701 270 A (BOC GROUP INC) 13 March 1996 (1996-03-13) column 3, line 40 -column 4, line 50; figure 1	8,9
EP 0 795 623 A (LEYBOLD SYSTEMS GMBH) 17 September 1997 (1997-09-17) column 2, line 57 -column 3, line 45; figures 1-3	
	·
	·
•	

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					<u> </u>
EP 0908531	Α	14-04-1999	EP	0908531 A2	14-04-1999
			JP	11172430 A	29-06-1999
			US 	6238527 B1	29-05-2001
EP 0860513	Α	26-08-1998	EP	0860513 A2	26-08-1998
			ΕP	0860514 A2	26-08-1998
			JP	3332839 B2	07-10-2002
			JP	11001771 A	06-01-1999
			JP	3332840 B2	07-10-2002
			JP	10298753 A	10-11-1998
			US	6451184 B1	17-09-2002
			US	6200431 B1	13-03-2001
US 4392939	Α	12-07-1983	NL	8200902 A	03-10-1983
			ΑT	22752 T	15-10-1986
			ΑU	560381 B2	02-04-1987
			ΑU	1203283 A	08-09-1983
			CA	1192318 A1	20-08-1985
			DE	3366772 D1	13-11-1986
			EP ·	0000403 AI	14-09-1983
			ES	8401678 A1	01-03-1984
			JP	1591463 C	30-11-1990
			JP	2014425 B	09-04-1990
			JP 	58164783 A	29-09-1983
US 5427665	Α	27-06-1995	DE	4025231 A1	16-01-1992
			DE 	4038577 A1	11-06-1992
EP 0701270	Α	13-03-1996	ΑU	2857595 A	21-03-1996
			CA	2156350 A1	07-03-1996
			CN	1126365 A	10-07-1996
			DE	69508011 D1	08-04-1999
			DE	69508011 T2	15-07-1999
			EP	0701270 A1	13-03-1996
			JP	8170172 A	02-07-1996
			SG	32468 A1	13-08-1996
			US	5645699 A	08-07-1997
			ZA 	9506811 A	14-05-1996
EP 0795623	Α	17-09-1997	DE	19609970 A1	18-09-1997
			DE	59609093 D1	23-05-2002
			EP	0795623 A1	17-09-1997
			ES	2173243 T3	16-10-2002
			JP	10008247 A	13-01-1998
			KR	269006 B1	16-10-2000
			TW	419527 B	21-01-2001
			US	2002157945 A1	31-10-2002

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 C23C14/00 H01J37/34

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) $IPK\ 7 \quad C23C \quad H01J$

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ, INSPEC, COMPENDEX

Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	EP 0 908 531 A (CANON KK) 14. April 1999 (1999-04-14)	1,3,4,6, 7,11
Υ	Absätze '0033!-'0035!,'0041!,'0042!; Abbildung 2	5,8-10
X	EP 0 860 513 A (CANON KK) 26. August 1998 (1998-08-26) Spalte 16, Zeile 52 -Spalte 18, Zeile 14; Abbildung 9	1,2,4,6, 7,11
Y	US 4 392 939 A (CROMBEEN JACOBUS E ET AL) 12. Juli 1983 (1983-07-12) Spalte 2, Zeile 60 -Spalte 3, Zeile 19; Abbildung 1	5

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie .
 Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : 'A' Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist 'E' älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist 'L' Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) 'O' Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht 'P' Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist 	 *T' Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist *X' Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden *Y' Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist *&' Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Recherchenberichts
8. Dezember 2003	17/12/2003
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016	Bevollmächtigter Bediensteter Hoyer, W

		<u> </u>	701210
	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kom	menden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Υ	US 5 427 665 A (HARTIG KLAUS ET AL) 27. Juni 1995 (1995-06-27) Spalte 3, Zeile 53 -Spalte 4, Zeile 51; Ansprüche 1,6,8; Abbildungen 2-4		8,9
Y	EP 0 701 270 A (BOC GROUP INC) 13. März 1996 (1996-03-13) Spalte 3, Zeile 40 -Spalte 4, Zeile 50; Abbildung 1		8,9
Υ	EP 0 795 623 A (LEYBOLD SYSTEMS GMBH) 17. September 1997 (1997-09-17) Spalte 2, Zeile 57 -Spalte 3, Zeile 45; Abbildungen 1-3		10

	lecherchenbericht artes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
FP	0908531	A	14-04-1999	EP	0908531	Δ2	14-04-1999
	0300001	,,	T-1 O 1 TOO	JP	11172430		29-06-1999
				ÜS	6238527		29-05-2001
					0230327		
EP	0860513	Α	26-08-1998	EP	0860513		26-08-1998
				EP	0860514		26-08-1998
				JP	3332839	B2	07-10-2002
				JP	11001771	Α	06-01-1999
				JP	3332840		07-10-2002
				JР	10298753		10-11-1998
				US	6451184		17-09-2002
				ÜS	6200431		13-03-2001
US	4392939	Α	12-07-1983	NL	8200902		03-10-1983
				ΑT	22752		15-10-1986
				AU	560381		02-04-1987
				AU	1203283		08-09-1983
				CA	1192318		20-08-1985
				DE	3366772	D1	13-11-1986
				EP	0088463	A1	14-09-1983
			•	ES	8401678		01-03-1984
				JP	1591463		30-11-1990
				JP	2014425		09-04-1990
				JP	58164783		29-09-1983
US	5 5427665	Α	27-06-1995	DE	4025231		16-01-1992
				DE	4038577	A1	11-06-1992
FP	0701270	 A	13-03-1996	AU	2857595	Α	21-03-1996
	0,012,0	• •	10 00 1010	CA	2156350		07-03-1996
				CN	1126365		10-07-1996
				DE	69508011		08-04-1999
				DE	69508011		15-07-1999
				EP	0701270		13-03-1996
				JP	8170172		02-07-1996
				SG	32468		13-08-1996
			•	US			08-07-1997
					5645699		
				ZA 	9506811 	A 	14-05-1996
EP	0795623	Α	17-09-1997	DE	19609970	A1	18-09-1997
				DE	59609093	D1	23-05-2002
				EP	0795623		17-09-1997
				ES	2173243		16-10-2002
				JP	10008247		13-01-1998
				KR	269006		16-10-2000
				TW	419527	В	21-01-2001